

**11月30日(木) (Thursday 30 November)**

**オープニング 9:55~10:00 【「鳳」】**

9:55~10:00 開会挨拶  
幹事長 田中 保宣 (産業技術総合研究所)

**セッション I :基調講演 10:00~11:30 【「鳳」】**

10:00~10:45 レゾナックにおけるカーボンニュートラルへの取り組みと事例紹介  
I-1 Carbon neutral initiatives and illustration of Resonac  
【基調講演】 福島正人 ((株)レゾナック・ホールディングス)

10:45~11:30 GaN パワートランジスタにおける表面・界面制御  
I-2 —GaN HEMT の進展と MOSFET の課題—  
【基調講演】 Surface and Interface Control of GaN Power Transistors  
橋詰 保 (名古屋大学)

(昼食休憩: 11:30~13:00)

**セッション II :招待講演(SiC 材料・評価技術) 13:00~14:00 【「鳳」A 会場】**

13:00~13:30 大口径 4H-SiC(0001)ウエハに残留した加工変質層の可視化とエピ欠陥  
II-1 への影響  
【招待講演】 Visualization of Sub-surface Damage Layer on 4H-SiC (0001) Wafers and Its Effect on Epitaxial Defects  
堂島 大地 (関西学院大学)

13:30~14:00 SiC トレンチ MOS チャネルの直接評価術 — 3D-VDP 素子  
II-2 Direct evaluation technique for SiC trench MOS channel – 3D-VDP  
【招待講演】 平井 悠久 (産業技術総合研究所)

**セッション III :招待講演(GaN 材料・デバイス) 13:00~14:00 【「鳳」B 会場】**

13:00~13:30 パルススパッタリングによる GaN および AlGaIn 電子素子の作製  
III-1 Preparation of GaN and AlGaIn electron devices by Pulsed Sputtering  
【招待講演】 藤岡 洋 (東京大学)

13:30~14:00 GaN 基板・デバイスのレーザスライス  
III-2 Laser slicing of GaN substrates and devices  
【招待講演】 田中 敦之 (名古屋大学)

(休憩: 14:00~14:15)

**インダストリアルセッション 14:15~15:15 【「鳳」A/B 会場】**

14:15~15:15 インダストリアルセッション I/II

**ポスターセッション I 15:15~17:45 【ポスター会場「瑞雲」】**

15:15~16:30 前半 (I A)  
16:30~17:45 後半 (I B)

**懇親会 18:00~20:00 【ANA クラウンプラザホテル「鳳」】**

18:00~20:00 懇親会

**12月1日(金) (Friday 1 December)**

**セッションIV:招待講演(SiC デバイス・システム) 9:30~11:30 【「鳳」A 会場】**

- 9:30~10:00 次世代 EV に求められる低損失 SiC パワー半導体設計指針とその実装技  
IV-1 術  
【招待講演】 Design Strategy of High Efficiency Power Semiconductor Devices and Its Packaging  
Techniques for Next Generation Electric Vehicle  
山本 真義 (名古屋大学)
- 10:00~10:30 電力変換器の将来:USPM によるパワエレクトロニクスシステムの統合化  
IV-2 Future of Power Converters: Power Electronics System Integration with USPM  
【招待講演】 伊東 淳一 (長岡技術科学大学)
- 10:30~11:00 SBD 内蔵 SiC-MOSFET の開発  
IV-3 Development of SBD-embedded MOSFET  
【招待講演】 日野 史郎 (三菱電機株式会社)
- 11:00~11:30 過酷環境向け SiC-CMOS 技術の信頼性とその応用  
IV-4 Reliability and Application of SiC-CMOS Technology for Harsh Environments  
【招待講演】 増永 昌弘 (株式会社日立製作所)

**セッションV:招待講演(WBG 材料) 9:30~11:30 【「鳳」B 会場】**

- 9:30~10:00 大口径ヘテロエピタキシャルダイヤモンド基板作製と応用  
V-1 Fabrication of large area heteroepitaxial diamond substrates and its applications  
【招待講演】 金 聖祐 (Orbray 株式会社)
- 10:00~10:30 車載適用を見据えた高温ガス成長法による SiC 結晶成長とカーボン  
V-2 ニュートラル  
【招待講演】 SiC Crystal Growth by High Temperature Chemical Vapor Deposition Method  
for Automotive Applications and Carbon Neutrality  
金村 高司 (株式会社ミライズテクノロジーズ)
- 10:30~11:00 貼り合わせ基板 SiCkrest の開発  
V-3 Development of Bonded SiC Substrate“SiCkrest”  
【招待講演】 小林 元樹 (株式会社サイコックス)
- 11:00~11:30 SiC SJ デバイス実現に向けた CVD 法による 4H-SiC 埋戻し成長技術  
V-4 の開発と進展  
【招待講演】 The development and status on 4H-SiC CVD trench filling technology for super-junction  
devices  
紀 世陽 (産業技術総合研究所)

(昼食休憩: 11:30~13:00)

**ポスターセッションII 13:00~15:30 【ポスター会場「瑞雲」】**

13:00~14:15 前半(II A)

14:15~15:30 後半(II B)

(休憩: 15:30~15:45)

**セッションVI:基調講演 15:45～16:30【「鳳」】**

15:45～16:30 半導体・デジタル産業戦略

VI-1 The Strategy for Semiconductor and Digital Industry

【基調講演】 清水 英路

(経済産業省商務情報政策局情報産業課デバイス・半導体戦略室 室長)

**セッションVII:昨年度奨励賞受賞記念講演 16:30～17:10【「鳳」】**

16:30～16:50 高温動作集積回路を目指した SiC 基板へのイオン注入によるボトムゲート JFET の作製

VII-1 Fabrication of bottom-gate JFETs by ion implantation into a SiC substrate for high-temperature IC operation

【依頼講演】 柴田 峻弥, 松岡 大雅, 金子 光顕, 木本 恒暢 (京都大学)

16:50～17:10 量子技術応用に向けた SiC MOS 界面単一光子源の制御

VII-2 Controlling The Properties of Single Photon Emitters at SiC MOS Interfaces for Quantum Applications

【依頼講演】 中沼 貴澄, 田原 康佐, 朽木 克博, 志村 考功, 渡部 平司, 小林 拓真 (大阪大学)

**奨励賞授賞式・クロージング 17:10～17:30【「鳳」】**

17:10～17:30 奨励賞授賞式

クロージング